

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第2区分

【発行日】平成20年5月22日(2008.5.22)

【公開番号】特開2002-66751(P2002-66751A)

【公開日】平成14年3月5日(2002.3.5)

【出願番号】特願2001-110713(P2001-110713)

【国際特許分類】

B 23 K 15/00 (2006.01)

B 23 K 103/08 (2006.01)

【F I】

B 23 K 15/00 506

B 23 K 15/00 501B

B 23 K 103:08

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月7日(2008.4.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エーロフォイル構造体の製造のため超合金材料(12)間の接合部(10)を電子ビーム溶接する方法であって、当該方法が、超合金材料からなる溶接可能なシム(14)を接合部に挿入し、これら超合金材料を電子ビームで加熱する工程を含んでおり、上記シムが0.040インチ(1.016mm)～0.100インチ(2.54mm)の厚さを有していて、上記加熱工程が、100～130kVの電圧及び25～35mAの電流で20～30インチ/分(50.8～76.2cm/分)の速度で電子ビームを加速することを含む、方法。

【請求項2】 前記シム(14)が鍛造、鑄造又は粉末冶金法で形成される、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 前記加熱工程が、電子ビームを高電圧又は低電圧電子ビーム溶接機で加速することを含み、その際の電圧が接合部(10)の完全な溶込みに十分な高さで、電流がベース金属及びシム(14)の完全な溶融を達成するものである、請求項1に記載の方法。

【請求項4】 前記加熱工程を単一パスで完了する、請求項1に記載の方法。